

「無電解 Ni/Au UBM 形成サービス」の開始について

日鉱金属株式会社（本店：東京都港区虎ノ門二丁目 社長：岡田昌徳 以下「当社」）は、当社磯原工場において、「無電解ニッケル／金めっきプロセスによるUBM（アンダー・バンプ・メタラジー）形成サービス」（以下「本サービス」）を本年1月から本格的に開始することといたしました。

本サービスは、1.2インチまでの半導体ウェハの電極パッドにニッケルめっきおよび金めっきを無電解により施すものであり、従来の電解めっき、スパッタリングによるプロセスと比較して工程を簡略化できることから、より低コスト化・短納期化が可能となります。また、当社が独自に開発しためっき液及びプロセスを使用することにより、パッド間の電位差やパッドサイズの影響を受けにくく均一なUBMの形成を実現しました。また、WLCSP（ウェハーレベルチップサイズパッケージ）等の銅再配線による銅パッドへの無電解ニッケル／金めっきへの対応も可能です。本サービスの開始にあたっては、数社の量産試験を行い良好な結果を得られたことから、今般の発表に至ったものであります。

半導体ウェハの市場は今後更なる成長が見込まれており、電子機器の小型化・高性能化が求められる中、LSIは高集積化の実現のために三次元配線での実装に移行してきており、配線ルールそのものの微細化も進展しております。こうした動向に対応し、当社は本サービスを順次拡張していく計画であり、2年後を目処に半田バンピング形成サービスを開始する予定です。

なお、本サービスの詳細については、1月16日から東京ビッグサイトにおいて開催される「半導体パッケージング技術展」の当社ブースにおいて展示する予定であります。

以上

（ご参考）

本サービスの標準仕様

ウェハー材質	Si 等
ウェハーサイズ	4"～12"
パッド材質	Al, AlSiAlCu, AlSiCu, Cu
UBM仕様	無電解 Ni/Au、Ni/Pd/Au
Ni/Au仕様	Ni：P品位 5～10%、厚み 1～5 μm Au：厚み 0.05～0.5 μm
Ni/Pd/Au仕様	上記 Ni/Au に Pd (0.05～0.1 μm) をめっき



12インチウェハー対応めっきライン

【お問合せ先】

日鉱金属株式会社 総務担当 河田

TEL : 03-5573-7223